

**Obsah**

1	Rozdělení látek z hlediska elektrické vodivosti	1-1
1.1	Energetické hladiny a pásy .....	1-2
1.2	Pásové diagramy .....	1-3
1.3	Fermi - Diracova rozdělovací funkce .....	1-3
1.4	Polovodičové materiály dříve a dnes .....	1-3
2	Fyzikální základy polovodičů	2-1
2.1	Vlastní (intrinický) polovodič .....	2-2
2.2	Nevlastní polovodič typu P .....	2-2
2.3	Nevlastní polovodič typu N .....	2-3
2.4	Pásové diagramy polovodičů .....	2-5
2.5	Transport nosičů náboje .....	2-8
2.6	Injekce nosičů náboje .....	2-8
2.7	Generace a rekombinace nosičů náboje .....	2-9
2.8	Jevy v silném elektrickém poli .....	2-9
3	Princip a vlastnosti PN přechodu	3-3
3.1	Polarizace PN přechodu .....	3-4
3.2	Difúzní napětí .....	3-5
3.3	V-A charakteristika a Shockleyho rovnice .....	3-6
3.4	Bariérová a difúzní kapacita .....	3-7
3.5	Praktická provedení diod .....	3-8
3.6	Struktura PIN .....	3-8
4	Diody – ostatní typy	4-1
4.1	Stabilizační diody .....	4-3
4.2	Tunelová dioda .....	4-5
4.3	Přechod kov – polovodič .....	4-7
4.4	Parametry diod .....	4-8
4.5	Dioda jako spínací prvek .....	4-8
5	Bipolární tranzistor (BJT)	5-1
5.1	Princip činnosti bipolárního tranzistoru .....	5-3
5.2	Tranzistorový jev .....	5-4
5.3	Základní zapojení tranzistoru .....	5-6
5.4	V-A charakteristiky tranzistoru .....	5-8
5.5	Modely tranzistoru .....	5-11
5.6	Obvody pro nastavení pracovního bodu .....	5-13
5.7	Vliv obvodových veličin a teploty na vlastnosti tranzistoru .....	5-15
5.8	Pracovní oblast tranzistoru .....	5-16
5.9	Darlingtonovo zapojení .....	5-16
5.10	Technologie výroby tranzistoru .....	5-17
5.11	Mezní kmitočet tranzistoru .....	5-19
5.12	Základní zesilovací stupně .....	5-19
5.13	Tranzistor jako spínač (saturační režim) .....	5-19
6	Tranzistory řízené elektrickým polem (FET)	6-1
6.1	JFET (tranzistor s přechodovým hradlem) .....	6-7
6.2	MESFET .....	6-8
6.3	MISFET (resp. MOSFET) .....	6-14
6.4	Tenkovrstvé FET (TFT) .....	6-15
6.5	Zvláštní provedení tranzistorů MISFET .....	6-18
6.6	Technologie CMOS (Complementary MOS) .....	6-18
6.7	MISFET jako spínač .....	6-21
6.8	Teplotní závislost unipolárních tranzistorů .....	6-21
6.9	Body-dioda a parazitní bipolární tranzistor .....	6-21

## ELEKTRONICKÉ PRVKY

7	Výkonové a spínací aplikace tranzistorů	
7.1	Ztrátový výkon a chlazení součástky.....	7-1
7.2	První a druhý průraz bipolárního tranzistoru .....	7-3
7.3	Spínání induktivní zátěže tranzistorem .....	7-4
7.4	Spínací a lineární režim .....	7-8
7.5	SOA – Bezpečná pracovní oblast .....	7-10
8	Ostatní spínací součástky	
8.1	Diak.....	8-1
8.2	Tyristor .....	8-1
8.3	Další typy tyristorů.....	8-6
8.4	Triak.....	8-8
8.5	Transil a trisil .....	8-8
8.6	IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) .....	8-9
9	Operační zesilovač (OZ)	
9.1	Schématická značka, základní pojmy .....	9-1
9.2	Ideální a reálný operační zesilovač.....	9-2
9.3	Zpětná vazba .....	9-5
9.4	Praktické použití záporné zpětné vazby.....	9-7
10	Součástky řízené neelektrickými veličinami	
10.1	Optoelektronické součástky .....	10-1
10.2	Termistory – součástky řízené teplotou.....	10-9
10.3	Součástky řízené magnetickým polem.....	10-10